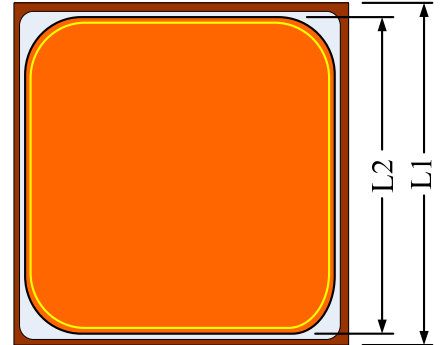


## 1N5820-55/1N5822-55/SR360-55 肖特基二极管芯片

**简述:**

- ✚ 本肖特基二极管芯片采用硅外延工艺制造;
- ✚ 损耗功率小, 效率高;
- ✚ 采用瞬态反应能力的保护环结构;
- ✚ 具有较高 ESD 抗静电击穿能力;
- ✚ 具有高抗浪涌电流能力;
- ✚ 可广泛应用于开关电源、整流电路及极性保护电路等各类电子电路中;
- ✚ 芯片图形尺寸:  $1400 \times 1400 \mu\text{m}$ ;
- ✚ 芯片厚度:  $280 \pm 10 \mu\text{m}$ ;
- ✚ 可分别适用于轴向封装、表面贴封装及金丝和硅铝丝压焊封装。



芯片尺寸示意图

 芯片尺寸 L1:  $1400 \mu\text{m}$ ;

 压点尺寸 L2:  $1310 \mu\text{m}$ ;

**极限参数:**

参数名称	符号	额定值			单位
		1N5820-55	1N5822-55	SR360-55	
最大直流阻断电压	$V_{RRM}$	20	40	60	Volts
正向平均整流电流	$I_{FAV}$	3			Amps
正向峰值浪涌电流 @ 8.3ms	$I_{FSM}$	50			Amps
最高工作结温	$T_J$	125			$^{\circ}\text{C}$
芯片存储温度	$T_{STG}$	-40 ~ +125			$^{\circ}\text{C}$
最低抗静电电压	ESD	8000			Volts

**电参数及规格 ( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ):**

参数名称	符号	测试条件	额定值			单位
			1N5820-55	1N5822-55	SR360-55	
反向击穿电压	$V_{BR}$	$I_R=100 \mu\text{A}$	$\geq 25$	$\geq 45$	$\geq 65$	Volts
正向压降	$V_F$	$I_F=3\text{A}$	$\leq 0.48$	$\leq 0.58$	$\leq 0.63$	Volts
反向漏电流	$I_R$		$I_R \leq 50 @ V_R=25\text{V}$	$I_R \leq 50 @ V_R=45\text{V}$	$I_R \leq 50 @ V_R=65\text{V}$	$\mu\text{Amps}$
特性曲线 $\Delta V_R \leq$	$\Delta V_R$	$I_{R1}=50 \mu\text{A}$ $I_{R2}=500 \mu\text{A}$	$\leq 4$			Volts